PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-315687

(43) Date of publication of application: 26.11.1993

(51)Int.CI.

H01S 3/096 G11B 7/125

(21)Application number: 04-124068

(71)Applicant : SONY CORP

(22)Date of filing:

17.04.1992

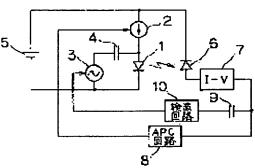
(72)Inventor: YUASA MASAMI

(54) APPARATUS FOR CONTROLLING SEMICONDUCTOR LASER OUTPUT

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a device for reducing laser noise by allowing high-frequency current in a laser diode, so as to reduce the power consumption of the laser diode, decrease the undesirable radiation level due to a disc and eliminate the level adjustment of high-frequency current.

CONSTITUTION: A photodetector 6 and a converter 7 cooperate to produce a first control signal depending on the level of the output from a semiconductor laser 1, and the ac component of the first control signal is extracted by a capacitor 9. The ac component contains the fluctuation due to laser noises. A detector circuit 10 detects the amplitude of the ac component, and produces a second control signal depending on the detected amplitude. The second control signal is fed back to a high-frequency current source 3 for the amplitude control of the source current. As a result, the high-frequency current source is so controlled that the ac component in the first control signal may become constant; therefore, laser noises are sufficiently suppressed.



LEGAL STATUS

Date of request for examination

Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

(19)日本国称幹庁 (JP)

群公報(A) 那年 (12) **(3)**

(11)特許出願公開番号

特開平5-315687

(43)公開日 平成5年(1993)11月26日

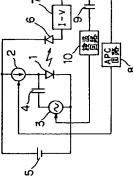
技術表示箇所

ᇤ 斤内整理番号 A 8947-5D 被別記事 3/096 7/125 H 0 1 S (51) Int C. G11B 審査請求 未請求 請求項の数1(全6頁)

(21) 出版番号	特 關平4—124068	(71) 出題人 000002185	000002185	l
			ソニー株式会社	
日瀬田(乙)	平成4年(1992)4月17日		東京都品川区北品川6丁目7番35号	
		(72)条明者	翻洗 正美	
			東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ	."
			一株式会社内	
		(74)代理人 弁理士	弁理士 稲本 栽雄	

(54) 【発明の名称】 半導体ァーザの出射光制御装置

によりレーザノイズを低減する装置において、半導体レ 【目的】 半導体レーザ1に高周波電流を重畳すること 一ザ1の消費電力の低減化、ディスクによる不要輻射レ **くトの低下、及び高周按電流のレベトの無調整化を図** 【構成】 受光繋子6、変換器でによって半導体レーザ 1 が出射する出射光のレベルに応じた第1の制御信号が 生成され、第1の制御信号に含まれる交流成分がコンデ ズによる変勢が含まれている。コンデンサ9で抽出され た交流成分の板幅が検故回路10で検抜され、板幅に応 じた第2の制御信号が高周波電流級3に帰還される。高 周波電流源3は、第2の制御信号に応じて挺幅が制御さ れる。従って、受光琳子6で受光され、変機器1で変換 された第1の制御信号に含まれる交流成分が一定となる ように高周故亀荒殿 3 が制御されるので、ワーザノイズ ンナ9に11抽出される。この枚割成分には、フー步ノイ の発生が良好な条件にて哲圧される。



[特許請求の範囲]

「静水垣1】 半導体レーザに南周波電視を虹畳してレ - 护ノイドが舟垓かの被肩かもりた.

哲野半導体レーザの出針光量に応じた第1の慰御信号が 生成する第1の信号生成手段と、 **寸配第1の制御信号の交流成分の版幅に応じた第2の**制 単信号を生成する第2の信号生成年段と、 **打記第2の制御信号に応じて版幅が制御される高周被電 前を発生する高周波電視発生手段とを備えたことを特徴** とする半導体レーザの出射光制御装置。

[発明の詳細な説明]

[000]

ヤやコンパクトディスクプレーヤ毎の光学式情報能改装 置等において、レーザアームのパワーを制御する半導体 [磁業上の利用分野] 本発明は、ビデオディスクプレー レーザの出射光制御装置に関する。

[従来の技術] ビデオディスクやコンパクトディスク侮 **の光学式ディスクは、ディスク上にピットが形成されて** [0002]

なり、このパット上にフーナパー4か医科すると、その 反射光はピットの有無による光学的な変調を受ける。従 休の光針共プァーナは、仮図か取けたァーヂアームが向 気信号に変換し、さらにこれを矩形故に変換した後、復 **国段に供給して、ディスクに記録された情報を再生す**

ないか

[0003]ところで、緑米の光針代グレーヤにおける が多い。この半導体レーザのレーザパワーは、閻政依洋 性を有しており、外部温度が高くなるとレーザパワーが 域少することが知られている。このように外部塩度によ したワーポパワーが複動するか、ディスクかの糖取のれ 5 競取信号のS/Nが劣化する。このため、比較的低い **西波数符核のフーポパワーの変勢を存用するために、** in たレーザパワーが一定になるようにするサーボ (APC フー声ハーde光度☆、弁禅存フー声が旺いのちのいが 尊体レーザの出射光を受光繋子でモニタし、モニタされ サーボ: Automatic Power Contr 01 サーボ)が用いられる。

30

原動される場合、いわゆるシングルモードにて発展する られている。これは半導体レーザを構成する半導体結晶 が、ディスクからの反射光が半導体レーザに戻ると、に の戻り光成分により、レーザパワーが控動することが知 の2つのへき開面で作られる光学的共振器のほかに、半 【0004】また半導体レーがは、単独の直流観測にで 草体レーザのディスクの宮田と、ディスク田とで作られ スクの面接れ等によりディスクと半導体レーザとの距離 る第2の光学的な共版器が構成されるためであり、ディ 5枚勢すると、栢田故のワーサノイズが乾悩される。

ŝ

周夜電視を虹畳することが知られており、かかる装置の 【0005】 このような種因液のアーザノイズの配生や 氏数するために、半導体ワーチを駆動する駆動気流に張

特別平5-315687

8

俄要は特公昭59-9085号公領にも記載されてい

イアス電視を供給する電流取2と、高周級電視を直視力 [0006] 図4は、かかるAPCサーポと、英函故書 流の広蛩によるレーザノイズの构圧数置を併用した従来 の半路谷フーデの五気光気管数画の一弦の篠成やボナン ロック図かめる。図においた、半導体ワー护1には、く ット用コンデンサイを介して供給する高周被電視収3と が接続されており、またパイアス配流値を定める電威5 が気流弧2に接続されている。さらにAPCサーボのた

ð、計算符フーチ1をの田繋がれめフー声パーム物数光 資か色用に数数十の数数器(1 -V)7 が歌けられたな する受光祭子6、及び受光祭子6で光鶴変換された電流 り、変換器7の出力はAPC回路8に供給される。AP C回路8は複複路1の出力の直指フベッや核出し、この **月渡フペケが一向になるように馬渡数2かの供給される ベルト V 転換信 や 位的 上 の。** 9

[0001]図5は、色の従来の田野光気御設備の一角 の権政を示すブロック図であり、図4の従来例とは異な 南因彼亀飛艇3の出力の版稿を制御するように構成され り、APC回路8の出力は高周波電流取3に接続され、

2

[発明が解決しようとする課題] 従来の半導体レーザの 田射光制御数属は、受光発子6でモニタされる田射光の 田力ァベルを電視額2の電視値、又は高周数電視数3の [8000]

ゆ。 紡りた、 半導体フーチュの 中色的 なっし ナスワーの 乃五第60頁に掲載された「高周故障流蔵量法による半 ズ低域化」と聞される記事によれば、高周徴電視駅3の **該艦 パワーガノイズに 粒する 依存有 を 在して こる ことが** 回路8で検出されるのは受光森子6で受光される半導体 ノイメに朽じた種因数偽実設3の数据や医容したらめむ 成分を帰還するAPCサーボを形成することも考えられ 変動を柏圧することは可能である。しかしながら、19 **答られているが、宏え兵図5の箱米曳にしたも、APC** けではない。そこでAPC回路8を広帯板化して、交流 85年10月発行の「光学」第14巻第5年の第53回 資 タフーナー 布袋 アゲギゲィス グレフーナ のフー サノイ フーチュのフーチベワーの中も合にすがず、口扱フーチ 版稿を慰御することによって一定にするようにしてい

に帰還する方法も考えられているが、ループ金体の高速 兇」第18巻第5号の第348頁乃函第354頁に掲載 された「食婦適街による光ディスクシステムのフーザー ノイズ府政」と狙される記事によれば、東光戦中6七数 **出かれるレーザパワーの変動の交流収分のみを偏視数2** 作や、重S/N代、小型化が必要であり、映用的ではな [0009] せた、 年長2年5月第行の「フーザー串 るが、ノイズによる観覧台が免れない。

[0010] 泊りた、柏米の美国故院院譲るが出出する

20

-2-

気ディスクに対してはオーバースペックとなり、上述の [0011] また、ディスクとして高い反射率を有する 不要電力消費、不要輻射の上昇、半導体レーザ1の負担 アルミディスクと、反射率の低い光磁気ディスクの両方 の記録再生を可能にする記録再生装置に関する規格が提 教されているが、アルミディスクで十分効果を持つ高周 の上昇に伴う寿命の短縮等の問題は一層顕著なものとな 故電視を半導体レーザ1に供給するようにすると、光磁

2

歯量することによりレーザノイズを低減する装置におい 【0012】本発明は、半導体レーザ1に高周故電流を た、半導体レーザ1の消費電力の低減化、ディスクによ る不要輻射フベナの低下、及び高周波電流のフベナの無 調整化を図ることのできる半導体レーザの出射光制御装 電を提供することを目的とする。 20

30 出射光制御装置は、半導体レーザ1に高周波電流を重量 9、検液回路10と、検波回路10の出力である第2の る高周故電流発生手段としての高周故電流源3とを備え [課題を解決するための手段] 本発明の半導体レーザの の信号生成手段としての受光素子6、変換器1と、第1 の制御信号の交流成分の挺幅に応じた第2の制御信号を **したワー护ノイメを低減する装置やむした、半導体ワー** ザ1の出射光量に応じた第1の制御信号を生成する第1 制御信号に応じて扱幅が制御される高周波電流を発生す 生成する第2の制御信号生成手段としてのコンデンサ たことを特徴とする。

第2の制御信号が高周故電流頭3に帰還される。高周故 【作用】上記構成の半導体レーザの出射光制御装置にお が出射する出射光のレベルに応じた第1の制御倡号が生 **サ9にて抽出される。この女衹成分にはレーザノイズに** よる変動が含まれている。コンデンサ9で抽出された交 で変換された第1の制御信号に含まれる交流成分が一定 となるように高周波電流版3が制御されるので、レーザ 成され、第1の制御信号に含まれる交流成分がコンデン 荒成分の板幅が検波回路10で検波され、板幅に応じた [0015] 従って、受光素干6で受光され、変換器1 いては、受光繋子6、変換器1によって半導体レーザ1 電流表3は第2の制御信号に応じて振幅が制御される。 ノイズの発生が良好な条件にて物圧される。 [0016]

寸与し、その説明は適宜省略する。図1は、本発明の半 [実施例] 以下、本発明の実施例を図面を参照して税明 **する。なお、従来の場合と同様の部分には同一の符号を** #体レーザの出射光制御装置の一実施例の構成を示すプ

号としてAPC回路8に供給される他、直流カット用の コンデンサ9にも供給されており、変換器1の出力であ より抽出される。コンデンサ9により抽出された交流成 ての受光素子6、及び変機器1の出力は、第1の制御信 る第1の制御信号に含まれる交流成分がコンデンサ9に 分の信号の振幅が検波回路10で検波されて、第2の制 御信号として高周故電流頭3(高周故電流発生手段)に 帰還されている。一方、APC回路8の出力は図4の従 ロック図である。図において、第1の信号生成手段とし 米例と回接に、電流版2に帰還されている。

C回路8によって電流顔2を制御することにより、従来 変換器1の出力である第1の制御信号の比較的高い周波 **半導体フーヂ1のフーヂパワーの早毡的な姿勢は、AP** の場合と同様に抑圧される。本実施例においてはさらに 数変動成分 (交流成分) の擬幅が検被回路10で検出さ **れる。検波回路10で検出される交流成分の短幅は、レ** ナノイズによった変動を受けているので、この復幅が **- 定になるように高周波電流源の短幅を制御することに** [0017]以上の構成による動作について説明する。 よった、ワーずノイメの影響が気減される。

グラフ(イ)は、半導体レーザ1の電流ーパワーの特性 図、グラフ(ロ)は高周波配流頭3の発生する高周波電 【0018】図3は、半導体レーザ1に供給されるバイ 祇の故形、グラフ(ハ)はグラフ(ロ)の萬周故観戒を **供給した場合の半導体レーザ1の出射光の特性をそれぞ** アス電流とレーザパワーとの関係を示すグラフであり、 た数したいる。 [0019] グラフ(イ)において、横軸はパイアス配 (ロ) に示すような時間的に振幅の変化する電流が供給 流の強度を、縦軸はレーザパワーを示しており、関値電 流Aを供給すると、それより大きい電流に対してレーザ パワーは傾きBで略リニアに増加する。そこで、閾値電 流Aよりもわずかに低い電流値Fの電流を電流顔2から 半導体レーザ1に供給し、髙周波電流頭3からは、その 版幅が(AーF)の2倍よりも大きい髙周波電流を半導 される。なお、グラフ(ロ)は横軸に電流、縦軸に時間 体レーザ1に供給すると、半導体レーザ1にはグラフ を示している。

[0014]

[0020] グラフ(ロ)に見られるパイアス包戒を半 単体レーザ1に供給すると、半導体レーザ1は脳値亀流 Aよりも低い電流が供給される期間にてレーザパワーが て所定のレーザパワーが出力され、そのピークのパワー 傑勉にレーザパワーを示している。 尚、グラン(ハ)に 0 になり、関値電流Aを越える電流が供給される期間に Dは高周波電流頭3が発生する高周波電流の短幅に依存 する。このレーザパワーの時間的変化を示したのがグラ フ(ハ)であり、グラフ(ハ)においては複種に時間、 おいて、早均レーザパワーがCで示されている。

[0021] 図1の輿補倒においては、平均レーザパワ ーCが一定となるように、APC回路10にて低被源2

20

-3-

→Dが一定となるように検波回路10にて高周波電流原 2が発生する高周波電流の振幅 (グラフ (ロ) のE) が の観消値(グラフ(ロ)のF)が慰御され、ピークパワ

ザノイズを伴う高い周波数変動は検液回路10による高 パワーの比較的級やかな変動はAPC回路10による電 [0022] 図4、図5の従来の装置においては、グラ フ(ロ)のE又はFのいずれか一方のみが制御される様 **蔣設2041度フペケ(F) 豊御によった行なむれ、フー た、フー扩くワーの奴鬯が府核から植枝にかけて笹田が 投かむったのに出較した、本政権圏においたは、ワーサ 周徴電消隙3の版幅 (E) 制御によって行なわれるの**

(図3のグラフ (ハ) のC) は、電流取2の発生する性 消の電流値だけでなく、英周波電流版3の発生する高周 【0023】図2は、本発明の半導体レーザの出射光制 **卸装置の他の実施例の構成を示すプロック図であり、図** 1 の実施例と異なる点は、A P C回路 8 の出力が高周波 電流版3の板幅を制御する制御信号として、加算器11 故観流の擬幅にも依存するので、図2の政施例のように 平均的なレーザパワーの変動を拘圧するために、電流談 2及び高周夜電流原3をAPC回路8の出力によって共 により、検波回路10の出力に加算されている点であ る。すなむち、半導体ワーザ1の平均的ワーザパワー に慰御するようにしてもよいのである。

ど影響を与えない。例えばビデオディスクの場合、糖取 りRF信号の最高周波数は約10MH z であるので、髙 [0024] なお、図3のグラフ (ハ) においては、出 射光そのものの被形が周期的に変動するが、高周被配説 の周波数を、ディスクから読取られるキャリア周波数よ りも十分に高い周波数とすれば、醗取り能力にはほとん **習液低流の周波数は例えば50MH z 程度とすればよ**

[0025]

【発明の効果】以上のように本発明の半導体レーザの出 対光制御装置によれば、半導体レーザの出射光のパワー

に応じた第1の慰御信号に合まれる交流成分を検出して け、半導体レーザに供給される高周設電流の超幅を第2 の医容節やにより医御する袋につれのか、フー步ノイメ その版幅に応じた第2の制御信号を発生する年段を散

存賦平5-315687

€

.]

[0026] 検書すれば高周故電流の短幅を不必取に高 ばすことができると共に、ゲィスクからの不受輻射レベ めることなくレーザノイズを庇険させることができるの る食符を雨波できることがら、半導体フーザの野舎を超 で、不要な治療気力を必要とせず、半導体レーがに対す ルをも下げることができる。 2

によるレーザパワーの比較的高い周波数変動を切圧でき

【0027】さらには高周改成院の版幅の初期開整の無 関数化を図ることができる。

[図旧の簡単な説明]

【図1】本発明の半導体レーザの出射光制御装置の一臭 毎回の構成やボナブロック図である。 [図2] 本発明の半導体レーザの出射光制御数層の句の **政施例の構成を示すプロック図である。**

[図3] 半導体レーザとパイアス配流、及びレーサパワ **一との関係を示すグランである。** [図4] 従来の半導体レーザの出射光筒御数幅の一阕の

[図5] 将来の半導体レーザの出射光気管数隔の街の密 権政を示すプロック図である。

の構成を示すプロック図である。

1 非識祭フーシ [作号の説明]

复混合

高周被低消颠 (高周被電流発生年段)

コンかンキ はは 2

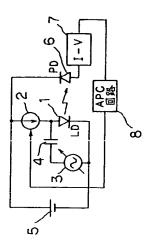
荧光器子

変換器 (第1の信号生成年段)

APC回路

10 検液回路 (第2の信号生成年段) ロンドンキ

<u>⊠</u>

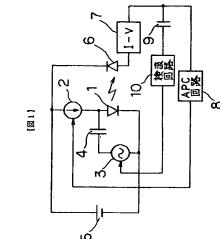


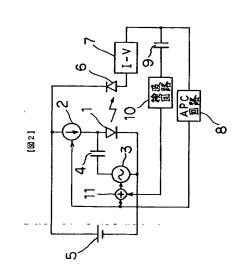
1

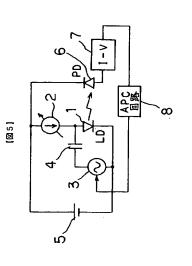
9



<u>@</u>







-9-